

半導体シリコンウェーハ洗浄および耐酸性用 高純度Ptfеウェーハカセットエッチングキャリア

商品番号: PL-CP09



前書き

半導体エッチングおよび洗浄用に設計されたプレミアムPTFEウェーハカセット。優れた耐HF性と高純度構造により、重要なウェットプロセスにおけるシリコンウェーハの安全な取り扱いを保証します。クリーンルーム環境における2インチから12インチの基板に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
HFエッチング	シリコンウェーハをフッ化水素酸に浸漬し、自然酸化膜や犠牲層を除去。	HFに対する完全な耐性により、材料の劣化や汚染がゼロ。
RCA洗浄	過酸化水素水とアンモニア水を含む標準化された多段階洗浄（SC-1およびSC-2）。	高純度PTFEがウェーハ表面への金属イオンの再堆積を防止。
太陽電池製造	テクスチャリングおよびリン拡散洗浄工程中のシリコンウェーハの取り扱い。	堅牢な設計が産業用太陽電池製造における高スループットをサポート。
化合物半導体	パワーエレクトロニクスおよびRF用途向けのGaAs、GaN、SiCウェーハの処理。	優しいスロット設計が、高価で脆い基板の損傷を防止。
フォトリソグラフィ	有機溶剤を用いたフォトレジスト現像および剥離プロセス中のウェーハの支持。	耐溶剤構造により、キャリアの膨張や軟化を防止。
CMP後すすぎ	化学機械研磨（CMP）後のウェーハの高純度すすぎにより、スラリーパーティクルを除去。	滑らかな表面により、すすぎ中の研磨粒子の完全な除去を促進。
MEMS製造	深部反応性イオンエッチング（DRIE）準備中の微小電気機械システムの重要な取り扱い。	精密なスロット加工により、複雑な微細構造ウェーハの位置合わせを維持。
超音波洗浄	超音波またはメガソニックタンクでの使用により、基板から微細な微粒子を除去。	材料はキャビテーション損傷に耐えながら、振動を効果的に減衰。

パラメータ	PL-CP09の仕様詳細
モデルシリーズ	PL-CP09（標準およびカスタムカセット）
材料	高純度バージンPTFE（ポリテトラフルオロエチレン）
ウェーハサイズ互換性	1", 2", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 6", 8", 12"
構成スタイル	シングルウェーハキャリア、マルチウェーハカセット、カスタムレイアウト
スロット容量（シングル）	1-5枚（最大12インチサイズまで利用可能）
スロット容量（マルチ）	標準25スロットまたはカスタマイズ高密度構成
使用温度	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
耐薬品性	すべての一般的な酸、塩基、溶剤（溶融アルカリ金属を除く）
製造工程	フルCNC加工（射出成形による汚染物質ゼロ）

パラメータ	PL-CP09の仕様詳細
ハンドルオプション	シングル垂直ハンドル、デュアルサイドハンドル、またはカスタムロボットインターフェース
表面仕上げ	Ra < 0.8 μm（高光沢仕上げは要望に応じて対応可能）

ウェーハサイズ	キャリアタイプ	標準スロット数	カスタマイズ可否
1インチ / 2インチ	シングル/マルチ	1, 5, 10, 25	完全にカスタマイズ可能
3インチ / 3.5インチ	シングル/マルチ	1, 5, 25	完全にカスタマイズ可能
4インチ / 4.5インチ	マルチウェーハ	25	ハンドルおよびピッチのバリエーション
5インチ / 6インチ	マルチウェーハ	25	ハンドルおよびピッチのバリエーション
8インチ / 12インチ	マルチウェーハ	13, 25	高精度カスタマイズ